

SuperKEKB 入射器におけるミスマッチメント、ジッターによるエミッタンス増大

EMITTANCE GROWTH BY MISALIGNMENTS AND JITTERS IN SUPERKEKB INJECTOR LINAC

清宮 裕史, 佐藤 政則, 諏訪田 剛, 肥後 寿泰, 榎本 嘉範, 宮原 房史, 古川 和郎

Y. Seimiya*, M. Satoh, T. Suwada, T. Higo, Y. Enomoto, F. Miyahara, K. Furukawa

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

In SuperKEKB injector linac, photocathode RF gun is used as electron source for low emittance high-charged beam. Main reason of the electron beam emittance blow-up is generally induced by wakefield in acceleration cavities. Off-center charged beam in a acceleration cavity is affected by the wakefield depending on the offset size in the cavity and the beam emittance is increased. The emittance blow-up can be eliminated by appropriate steering magnet control so as to cancel the wake effect in the cavity. We perform particle tracking simulation with both misalignments (quadrupole magnet + acceleration cavity) and jitters (quadrupole and steering magnetic force + beam position). Emittance growth by the misalignments and the beam jitter is evaluated in this report.

1. 導入

SuperKEKB は素粒子物理実験のための電子陽電子コライダーであり、デザインルミノシティは KEKB[1] の 40 倍である $8 \times 10^{35} \text{ cm}^{-2}/\text{s}$ である。高ルミノシティのため、入射器では高品質ビームが要求される。SuperKEKB の Phase1 は 2016 年 2 月から 6 月まで行われ、想定されていた様々な機器やソフトウェアのチェック、真空焼きが大きな問題なく進められ、無事 Phase1 を終えた。2017 年秋からの Phase2 では、最終的に低エミッタンスビームが要求されているため、入射器では Phase2 が終わるまでに低エミッタンスビームの輸送を確立する必要がある。

Fig. 1 は SuperKEKB 入射器の概略図である。入射器は、A, B, J-ARC, 1~5 のセクターから成る。規格化エミッタンスとして、Linac エンドにて 20mm.mrad 以下が要求されている。Linac には 2 種類の電子銃が存在する。一つは、高電荷電子ビーム (10nC) を生成する熱電子銃であり、主に陽電子を生成する目的で用いられる。陽電子ビームは、セクター 1 でのタングステンターゲットに 10nC の電子を衝突させることで生成される。その後、陽電子は damping ring (DR) に輸送され、エミッタンスが減衰される。DR は Phase2 から稼働予定である。最終的に、陽電子は 4GeV まで加速され SuperKEKB の LER(Low Energy Ring) に入射される。もう一つのカソードは、光カソードの RF 電子銃であり、5nC の低エミッタンスビーム (20mm.mrad 以下) を SuperKEKB リングへ輸送する目的で用いられる。この低エミッタンスビームは 7GeV まで加速され、SuperKEKB の HER(High Energy Ring) に入射される。運転は 50Hz、96ns 間隔の 2 バンチで行われる。

HER に入射するための電子ビームには、陽電子のための DR のような強力なエミッタンス減衰要素がない。そのため、エミッタンスを保存するための研究が進められてきた [2, 3, 4]。エミッタンス増大は主に加

速管内で生じる wake によって引き起こされる。ビームが加速管の軸から外れた場所を通過する場合、そのオフセット量に依存した量だけバンチ先頭の電子から生じた wake によって後続の電子が蹴られるためエミッタンスが悪化する。こうしたエミッタンス悪化は、加速管の中心を通るような軌道をステアリングで探し出すことである程度抑制することができる。しかし、4 極磁石や加速管のミスマッチメントだけでなく、電磁石の磁場やビームのジッターによってもエミッタンスは増大する。我々は、現実的な 4 極磁石や加速管のミスマッチメント、4 極磁石、ステアリング磁石の磁場ジッター、ビーム位置ジッターによるエミッタンス増大の評価を行った。

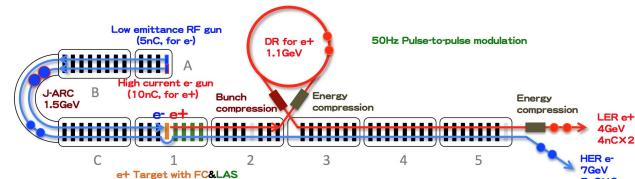


Figure 1: Schematic layout of the SuperKEKB injector linac.

2. シミュレーションの設定

SuperKEKB 入射器のセクター C からセクター 5 まで、加速管内の縦と横の短距離 wake 場 [5] を考慮したトラッキングシミュレーションを行った。短距離の wake 場のみを扱うのは、入射器で運転されるバンチ間隔が 96ns かつ S-band 加速管のみで構成されていることから、それ以上の中距離、長距離の wake 場を十分無視できるためである。このレポートでは、シミュレーションは Strategic Accelerator Design[6] で行われた。低エミッタンスチューニングの手順は以下のように行った。

* seimiya@post.kek.jp

Table 1: Basic Parameter Set, Aperture Values Indicate the Radius, δ is Relative Momentum Deviation

Parameter	Value	Unit
Initial emittance	10	mm.mrad
Initial charge	5	nC
Initial σ_z	3/2.35	mm
Initial δ	0.004	-
# of initial particles	40000	-
Distribution	Gaussian	-
S-band accelerator aperture	10	mm

1. BPM の測定値が 0 となるようにステアリングを用いて軌道補正
2. C セクター始めの 4 つのステアリングを用いて低エミッタスとなるような値を探す（オフセットインジェクション）

入射器では、BPM のリファレンスポイントは Quad-BPM 法により 4 極磁石の磁場中心で較正されている [7]。シミュレーションは BPM と最寄の 4 極磁石が同じ量だけミスマッチメントしているとして行った。現実的には BPM のリファレンスポイントと 4 極磁石の磁場中心は、およそ $50\mu\text{m}$ 程度のずれがあることが 3BPM で確かめられている [8, 9]。後に図示するように軌道補正後の軌道はピークピーカーで $\pm 2\text{mm}$ 程度であるため、 $50\mu\text{m}$ という量が低エミッタスチューニングへ及ぼす影響は十分小さい。軌道補正は、全 BPM の測定値の二乗和が最小になるようにステアリングの磁場値をセットすることで行った。オフセットインジェクションは低エミッタスを実現できる手法の一つである [10]。エミッタス増大の主な原因の一つは、加速管の中心からビームがオフセットすることでビームが wake 場によってオフセット量と進行方向の位置に依存して蹴られるためである。そのため一本の加速管のみを考えたとすると、オフセット量を 0 にするか、加速管の入口と出口のオフセット量が異符号になるようにステアリングを調整すれば良いことがわかる。つまり、オフセットインジェクションの目的は x, x', y, y' を 4 つのステアリングで変化させて wake によるエミッタス増大を最小限に抑えられる軌道を見つけることにある。シミュレーションでは、5 セクター最後でのエミッタスを見つつ、最小のエミッタスとなるステアリング値を滑降シンプレックス法で求めた。ここで、同じ架台に乗っている加速管（4 本）は同じミスマッチメントを仮定した。また、ダブルレット 4 極磁石についても同じミスマッチメントを仮定した。ステアリングについては、現実で設定可能なステアリングの最大磁場を超えないように調整を行った。Table 1 は、このシミュレーションにおける基本パラメータである。特に断らない限り、シミュレーションにはこの値を使うこととし、エミッタスは入射器 END でのエミッタスを表すこととする。

3. エミッタス増大

目標とするエミッタスは入射器 END で 20mm.mrad 以下である。エミッタス補正是、軌道補正とオフセットインジェクションによって行われる。4 極磁石と加速管のミスマッチメントはガウス分布で与えており、 3σ 以下の値のみを採用している。本レポートでは、エミッタスは RMS エミッタスを用いており以下のように定義される。

$$\epsilon_x = \gamma \beta \sqrt{\langle x^2 \rangle \langle x'^2 \rangle - \langle xx' \rangle^2}. \quad (1)$$

この式内においては、 γ と β はそれぞれローレンツ因子とローレンツ β を表す。

Fig. 2 は、RMS ミスマッチメントが 0.3mm のときのシミュレーション結果の一例である。青と赤はそれぞれ水平、垂直パラメータを表している。この図の一番上から、それぞれエミッタス、入射器 END までの通過粒子数、軌道、 β 関数、ディスページョン、相対的運動量偏差、バンチ長、4 極磁石のミスマッチメント、加速管のミスマッチメント、ステアリング磁石の K 値を表している。セクター 1 の中心付近からエミッタスが増加しているが、これはその場所に設置してあるシケインによってディスページョンが生じたためと考えられる。

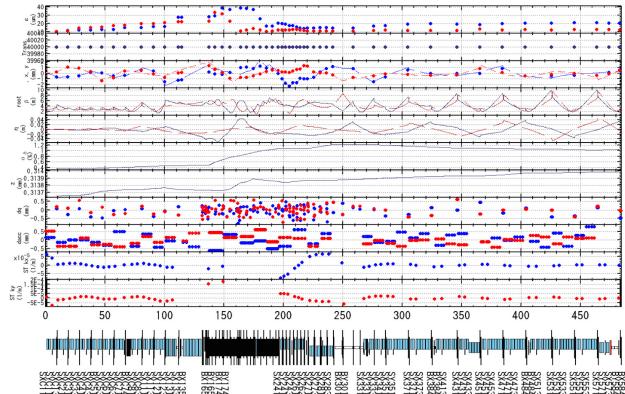


Figure 2: An example of beam parameters from sector C~5 with 0.3mm RMS misalignment of quadrupole magnets and acceleration cavities.

3.1 ミスマッチメント

RMS ミスマッチメントが 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm であるとき、それについて 60 種のミスマッチメントセットについてエミッタス補正を行った。このとき、ジッターは無いとした。ジッターについては次のサブセクションで扱う。Fig. 3 は水平エミッタス vs. 垂直エミッタスをプロットしたものであり、左図が 1 バンチの電荷が Phase2 時の 2nC、右図が Phase3 時の 5nC の場合である。2nC 時には 0.3mm のミスマッチメントでもエミッタス増大はほとんど問題にならないが、5nC 時には大きく影響することがわかる。5nC の際、RMS ミスマッチメントが 0.3mm の場合、エミッタスが 20mm.mrad を超える

ものが存在する。一方、0.1, 0.2mm の場合、エミッタンスが 20mm.mrad を超えるものは存在しない。そのため、Phase3 ではなくとも 0.2mm 程度以下に RMS ミスアライメントを抑える必要があることがわかる。(十分密にステアリングが配置されていればエミッタンス成長を抑えることは可能であるが、現実にはそうなっていないためどうしてもエミッタンス成長が生じてしまう。)

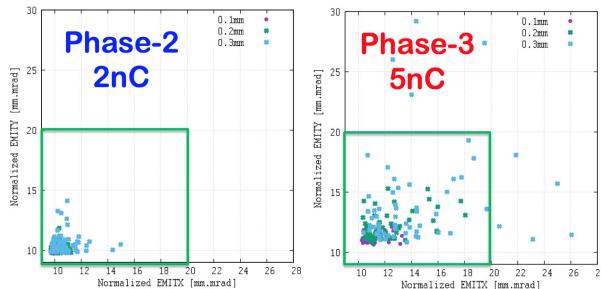


Figure 3: Emittance growth at the linac end for 60 random seed in each RMS misalignment in case of 2nC and 5nC.

Fig. 4 は、加速管もしくは 4 極磁石の RMS ミスアライメントを 0.1mm に固定した際、固定しない方の値を 0.1, 0.2, 0.3mm と変化させた時のエミッタンスをプロットしたものである。どちらもエミッタンス成長に寄与するが、4 極磁石のミスアライメントによるエミッタンス成長の影響が大きい。これは、4 極磁石のミスアライメントによって軌道が乱され、より大きな軌道をもつビームが加速管を通過してしまうためと考えられる。つまり、加速管と 4 極磁石の軸が一致していないと、エミッタンス成長してしまうと考えられる。

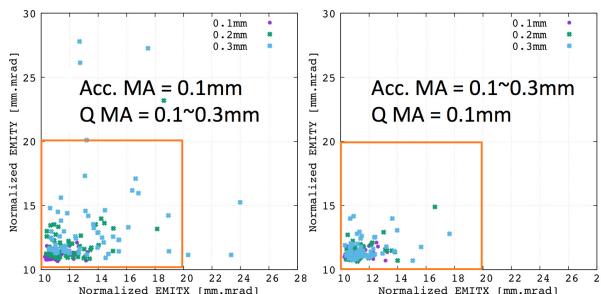


Figure 4: Emittance growth at the linac end for 60 random seed in each RMS misalignment in case that quadrupole or accelerator cavity misalignment is fixed to 0.1mm. "MA" is MisAlignment.

3.2 ミスアライメントとジッター

100 種のジッター（ステアリング、4 極磁石の磁場ジッター or ビーム位置ジッター）について、前セクションと同様に 60 種のミスアライメントにおけるエミッタンス補正を行った。与えたジッターの大きさは以下である。

- K_Q 値ジッター / 最大 K_Q 値= 0.32% (peak-peak).

- K_{ST} 値ジッター / 最大 K_{ST} 値= 0.08% (peak-peak).
- ビーム位置ジッター = 100 μm (ガウス分布).

ただし、 K_Q と K_{ST} はそれぞれ 4 極磁石、ステアリング磁石の K 値を表す。

Fig. 5 は、ステアリングと 4 極磁石の K 値のジッターが存在する場合のエミッタンスを示しており、黒点は 100 種のジッターのエミッタンス平均値を表したものである。赤ラインはさらに 60 種のミスアライメントに対するエミッタンスの平均値をプロットしたものである。黄点はジッターがない場合の 60 種のミスアライメントに対するエミッタンスの平均値である。4 極磁石の磁場ジッターによる影響よりも、ステアリングの磁場ジッターによる影響が大きく、ジッター量も 0.08% と小さいことから高精度なステアリング電源が必要となる。RMS ミスアライメントが 0.2mm の際でも、上記のジッターが存在する場合 20mm.mrad 以下の達成が確実ではないことがわかる。

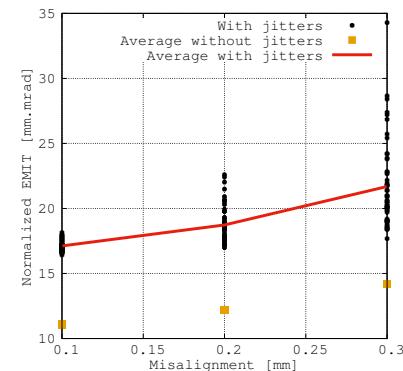


Figure 5: Emittance growth averaged for 100 kinds of jitters (K value) about 60 misalignment.

Fig. 6 は、ビーム位置ジッターが存在する場合のエミッタンスを示しており、黒点、赤ライン、黄点は Fig. 5 と同様である。図中の 3 つのヒストグラムは、それぞれの RMS ミスアライメントにおける 60 × 100 種のエミッタンスをヒストグラム化したものである。100 種のジッターにおけるエミッタンス平均値を見る限り、ビーム位置ジッターが 100 μm 以下ならば RMS ミスアライメントが 0.2mm でもおおよそ達成できるように感じるが、ヒストグラムを見ると、ミスアライメントが 0.1mm でも分布の裾が 20mm.mrad を超えていることがわかる。先ほどのステアリング、4 極磁石のジッターに関しても同様のことが言える。本レポートでは議論しないが、どの程度ならば 20mm.mrad を超えても許容されるのか今後調査を行う必要がある。また、ビームアングルジッターについて考慮していないため、許容ビーム位置ジッター量はより制限されると考えられる。これについても、今後調査予定である。

Fig. 7 は、電荷ジッターが 2% 存在する際のエミッタンスを示したものであり、黒点、赤ライン、黄点は Fig. 5 と同様である。赤ラインと黄点がほぼ同じであることから、2% 程度の電荷ジッターによるエミッ

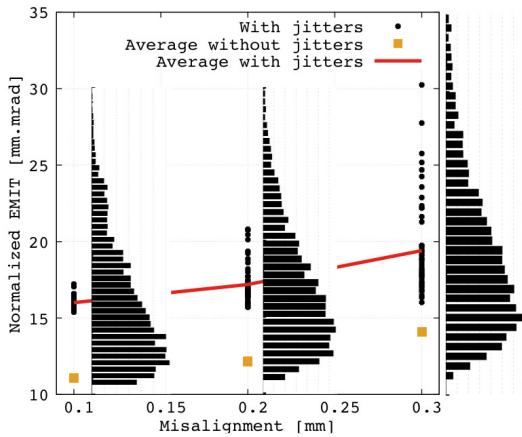


Figure 6: Emittance growth averaged for 100 kinds of beam position jitters in each 60 kinds of misalignments.

タンスへの影響は無視できる程度の小さいことがわかる。

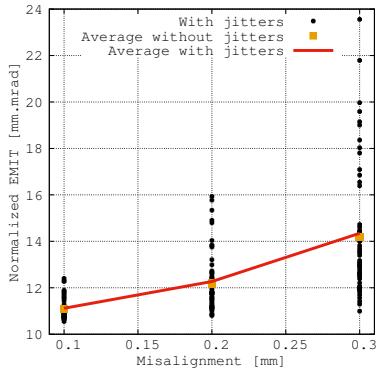


Figure 7: Emittance growth averaged for 100 kinds of bunch charge jitter in each 60 kinds of misalignments.

3.3 測定されたミスアライメント

入射器では、定期的に加速管を乗せる架台の位置変化を Si フォトダイオード (PD) で測定している。最近は要所要所に自動で架台の位置を測定する自動 PD も導入され、年月によって架台がどのように動いているか測定が行われている [11]。Fig. 8 の左端の図は、PD から推定した加速管のミスアライメントを表しており、横軸はセクター C からセクター 5 までの距離、縦軸がミスアライメント量を表している。ここでは、例として 2015 年 4 月と 2016 年 1 月に行つた 2 種を載せた。架台から見た加速管のミスアライメントは、架台自体のミスアライメント量より小さいと考えられるため、架台から見た加速管の RMS ミスアライメントは 0.1mm と仮定しエミッタス補正を行った。つまり、加速管の RMS ミスアライメントは以下のように記述できる。

$$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma_{frame}^2 + \sigma_{ACC}^2}, \quad (2)$$

ここで、 σ_{frame} は架台の RMS ミスアライメント、 σ_{ACC} は架台から見た加速管の RMS ミスアライメント

ントを表す。また、4 極磁石の RMS ミスアライメントとして 0.2mm を仮定し、ジッターについては考慮していない。左から 2~4 番目の図は、上記のミスアライメントが存在する際の水平 vs. 垂直方向のエミッタスを表しており、100 種のミスアライメント群についてプロットしたものである（黒点）。一方、セクターをまたいだジョイント部付近の架台において大きな位置変化が測定されており、どの程度の変化が許容できるかを調査するためにジョイント部付近の架台のミスアライメントを 2 倍、4 倍、8 倍にしてエミッタス補正を行った。その結果が、それぞれ左から 2 番目、3 番目、4 番目の図の赤点に対応している。デフォルト、2 倍、4 倍の結果は、およそ 20mm.mrad 以下に収まっているが、8 倍の場合には 20mm.mrad を超えるものがいくつも確認できる。ジョイント部における加速管のミスアライメントは、現状の 4 倍程度ならば許容できる可能性が高いことがわかる。

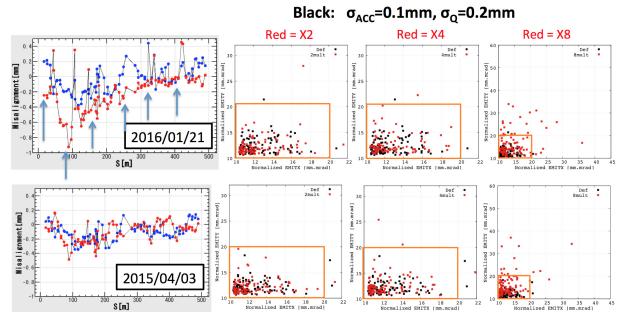


Figure 8: Frame position data measured by Photo-Diode (left-most) and emittance at the linac end in case of default measured misalignment, 2 times misalignment at the sector joint, 4times misalignment at the sector joint, and 8 times at the sector joint.

4.まとめ

4 極磁石と加速管にミスアライメントが存在する場合、4 極磁石とステアリング磁石の磁場ジッター、ビーム位置ジッターが存在する場合の低エミッタスチューニングシミュレーションを粒子トラッキングシミュレーションで行った。その結果から、目標であるエミッタス 20mm.mrad 以下を達成するためには、少なくとも 4 極磁石と加速管の RMS ミスアライメントが 0.2mm 以下であること、4 極磁石と加速管の中心軸が 0.2mm 以下で一致していること、ステアリングの磁場ジッターが最大磁場に対して 0.3% 以下であること、ビーム位置ジッターが 100 μm 以下であることを満たす必要がある。本レポートのシミュレーションにおいては、ビームアングルジッターを考慮していないため、ビーム位置ジッターはさらに抑える必要があると考えられる。現在の入射器におけるビーム位置ジッターは 100~200 μm であるため、位置ジッター減の特定と抑制が必須であり、現在調査が進められている。一方、電荷ジッターが 2% 程度存在してもエミッタスへの影響は無視できるほど

小さいことがわかった。PD 測定も積極的に行われており、現実に即したシミュレーションが可能となりつつある。

謝辞

This work was partly supported by JSPS KAKENHI
Grant Number 16K17545.

参考文献

- [1] KEKB Design Report, KEK Report 95-7.
- [2] L. Zang *et al.*, Proc. of IPAC2011, San Sebastian, Spain (2011).
- [3] H. Sugimoto *et al.*, Proc. of IPAC2012, New Orleans Louisiana, USA (2012).
- [4] S. Kazama *et al.*, Proc. of IPAC2015, Richmond, VA, USA (2015).
- [5] K. Yokoya, “Short-Range Wake Formulas for Infinite Periodic Pill-Box”, 1998.
- [6] Strategic Accelerator Design(SAD) home page; <http://accel-physics.kek.jp/SAD/>
- [7] M. Masuzawa *et al.*, Proc. of EPAC2000, Austria Center Vienna.
- [8] T. Suwada *et al.*, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 440, pp.307-319 (2000).
- [9] M. Satoh *et al.*, Particle Accelerator Society of Japan, WEPS097, 2012.
- [10] A.W Chao, B. Richter Meth. A 178, 1 (1980).
- [11] T. Suwada *et al.*, Particle Accelerator Society of Japan, TUP134, 2016.